

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 8 月 7 日(07.08.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/119445 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01) *H01L 33/52* (2010.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/051232
- (22) 国際出願日: 2014 年 1 月 22 日(22.01.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-014668 2013 年 1 月 29 日(29.01.2013) JP
特願 2013-053628 2013 年 3 月 15 日(15.03.2013) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 松下 孝夫(MATSUSHITA, Takao); 〒5190193 三重県亀山市布気町 919 番地 日東精機株式会社内 Mie (JP). 森 伸一郎(MORI, Shinichiro); 〒5190193 三重県亀山市布気町 919 番地 日東精機株式会社内 Mie (JP).
- (74) 代理人: 岡本 寛之, 外(OKAMOTO, Hiroyuki et al.); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 5 番 3 6 号 セントラル新大阪ビル 3 F いくみ特許事務所内 Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

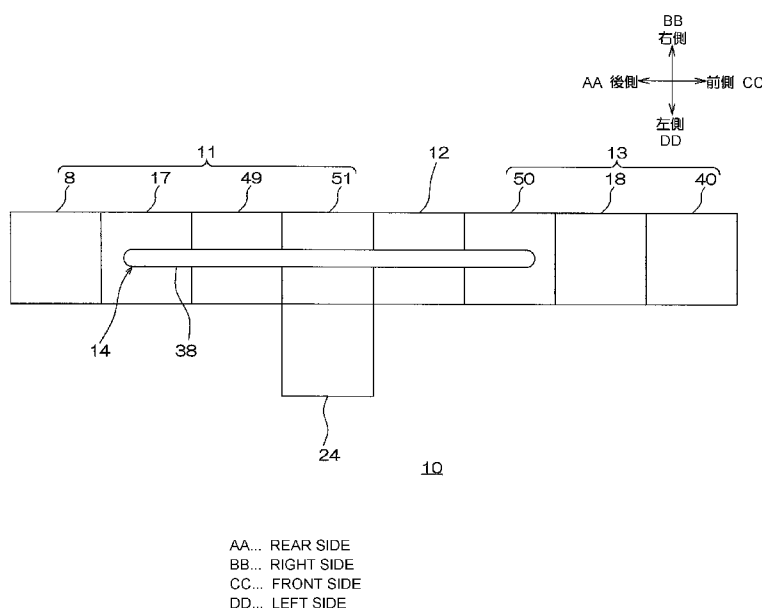
添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PRODUCTION METHOD AND PRODUCTION DEVICE FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

(54) 発明の名称: 半導体装置の製造方法および製造装置

[図1]



(57) Abstract: This method is a production method for semiconductor devices obtained by sealing semiconductor elements by using a sealing sheet. The production method for semiconductor devices comprises: a preparation step in which a sealing sheet and a plurality of semiconductor elements are prepared; a sealing step in which, after the preparation step, the plurality of semiconductor elements are sealed as a batch, by using the sealing sheet; and a recovery step in which, after the sealing step, the sealing sheet and the plurality of semiconductor elements are recovered.

(57) 要約: この方法は、封止シートによって半導体素子を封止することにより得られる半導体装置の製造方法である。半導体装置の製造方法は、封止シートおよび複数の半導体素子を準備する準備工程、準備工程の後に、封止シートによって複数の半導体素子を一括して封止する封止工程、および、封止工程の後に、封止シートおよび複数の半導体素子を回収する回収工程を備える。

WO 2014/119445 A1